

Влияние дефектов эпитаксиального слоя на напряжение пробоя высоковольтных арсенид-галлиевых структур

Aškinazi, G.; Zolotarevskaja, O.; **Meiler, Boriss** Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1978 / с. 64-66 : илл

https://www.ester.ee/record=b1262177*est

Влияние облучения низкоэнергетическими электронами в растровом электронном микроскопе на параметры полупроводниковых приборов

Meiler, Boriss; Kropman, Daniel; Levtsenkova, Alla Микроэлектроника 1987 / с. 165-169 : илл

https://www.ester.ee/record=b2147720*est

Изменение параметров интегральных схем при анализе в растровом электронном микроскопе

Meiler, Boriss Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 85-92

https://www.ester.ee/record=b1296001*est

Комплексное рентгенодифракционное исследование строения нарушенных слоев, обусловленных резкой кремнии

Milvidski, M.; Fomin, V.; **Meiler, Boriss** Физика и химия обработки материалов 1986 / с. 122-125

https://www.ester.ee/record=b1804847*est

Межфазное взаимодействие и ориентационные соотношения в системе Ni-GaAs

Meiler, Boriss XIII Всесоюзная конференция по электронной микроскопии, г. Сумы, окт. 1987 г : тезисы докладов : [В 2 т.].

1987 / с. 214-216

Межфазное взаимодействие и ориентационные соотношения в системе никкель - арсенид галлия

Meiler, Boriss Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 3-12

Межфазное взаимодействие на контакте Ni-Si и Ni-GaAs

Meiler, Boriss Поверхность : физика, химия, механика 1985 / с. 62-67 : илл https://www.ester.ee/record=b2149829*est

Металлографическое исследование арсенида галлия с помощью электрохимического травления

Meiler, Boriss Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 13-21

Опыт применения методов растровой и просвечивающей электронной микроскопии в исследованиях природного апатита

Pöldme, Meeme; Kallavus, Urve; Meiler, Boriss Технологическая минералогия фосфатных руд : тезисы докладов

всесоюзного совещания, 17-18 ноября 1987 г., Люберцы 1987 / с. 106-107

Основы электронной микроскопии : методическое пособие для пользователей

Meiler, Boriss 1990 http://www.ester.ee/record=b1231942*est

Подготовка напряженных хрупких образцов полупроводниковых материалов для просвечивающей электронной микроскопии

Meiler, Boriss Физическая химия соединений A/IV/B/IV/ 1987 / с. 44-48

Полупроводниковые материалы

Rusalep, Ervin; Kuk, Peeter-Enn; Krustok, Jüri; Mädasson, Jaan; Altosaar, Mare; Ruus, Tõnu; Aarna, Heiti; Mankin, Romi; Reiter, Eerik; Krunks, Malle; Mellikov, Enn; Seilenthal, Mats; Vallaste, Heikki; Tuvike, Tiit; Palmre, Õie; Bender, Villem; Veimer, Vladimir; Mere, Arvo; Roninson, Aleksander; Silas, Aarne; Gavrilov, Aleksei; Paat, Aadu; Meiler, Boriss 1986

https://www.ester.ee/record=b1296001*est

Полупроводниковые материалы

Varvas, Jüri; Nirk, Tiit; Oja, Alar; Kerm, Karin; Raukas, Maie; Öpik, Andres; Ahven, Tarmo; Valdna, Vello; Mädasson, Jaan; Türm, Leo; Reiter, Eerik; Meiler, Boriss; Gavrilov, Aleksei; Veimer, Vladimir; Kurik, Lembit; Silas, Aarne 1987

https://www.ester.ee/record=b1272914*est

Полупроводниковые материалы

Reiter, Eerik; Meiler, Boriss; Krustok, Jüri; Piibe, Toomas; Mädasson, Jaan; Altosaar, Mare; Tomson, A.; Kuk, Peeter-Enn; Tuvike, Tiit; Palmre, Õie; Vallaste, Heikki; Päid, Imbi; Kuusmets, Eela; Petrov, P.; Mellikov, Enn; Erm, Ants; Krunks, Malle; Gavrilov, Aleksei; Košelap, Andrei; Bender, Vladimir; Mere, Arvo; Veimer, Vladimir; Kurik, Lembit; Sinivee, Veljo 1988

https://www.ester.ee/record=b1220756*est

Процессы роста и формирование морфологии и структуры толстых автоэпитаксиальных слоев арсенида галлия при выращивании из раствора-расплава

Meiler, Boriss; Zolotarevski, L.; Orenstein, I.; Paat, Aadu Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika =

Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR.

Physics. Mathematics 1988 / lk. 310-314 : ill https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Рост и морфология толстых слоев арсенида галлия, выращенных жидкофазной эпитаксией

Meiler, Boriss; Zolotarevski, L.; **Paat, Aadu**; Orenštein, I. Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 24-26
https://www.ester.ee/record=b1262177*est

С "минус первого" - на первый

Meiler, Boriss Tallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja 1988 / с. 3
https://www.ester.ee/record=b1254708*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3cfd17a0-d98c-4a76-8aac-ee61f9acca5a>

Структура и глубина нарушенного слоя при грубой абразивной обработке монокристаллического кремния

Meiler, Boriss; Hatskevitš, M.; Ladotškin, A.; Fomin, V. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 60-71: ill

Термообработка пластин кремния с нарушенным слоем

Meiler, Boriss; Ladotškin, A.; Fomin, V. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 72-86: ill

Формирование морфологии и структуры толстых автоэпитакисальных слоев арсенида галлия при росте из раствора-расплава

Zolotarevski, L.; **Meiler, Boriss**; Orenštein, I.; **Paat, Aadu** Технология быстродействующих силовых полупроводниковых приборов : сборник статей 1989 / с. 192-197 : илл https://www.ester.ee/record=b1267766*est